



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 208497357 U

(45)授权公告日 2019.02.15

(21)申请号 201820881174.7

(22)申请日 2018.06.07

(73)专利权人 东莞市译码半导体有限公司

地址 523000 广东省东莞市常平镇卢屋村
创业二路3号

(72)发明人 殷泽安

(74)专利代理机构 深圳华奇信诺专利代理事务
所(特殊普通合伙) 44328

代理人 陈子勋

(51)Int.Cl.

B28D 5/00(2006.01)

B28D 7/00(2006.01)

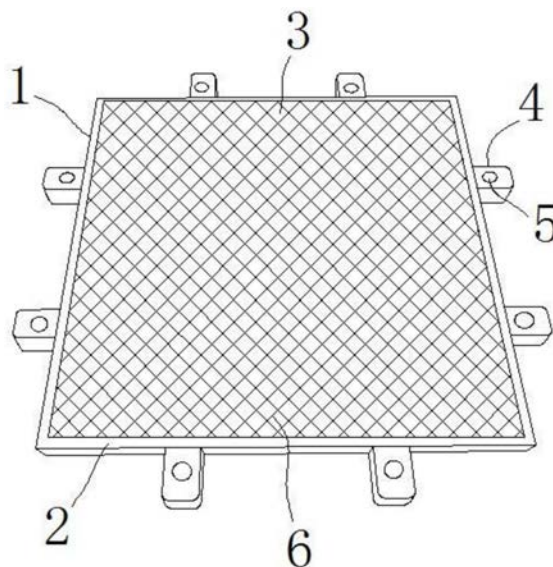
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

切割工作盘

(57)摘要

本实用新型涉及半导体切割设备技术领域，特指一种切割工作盘；本实用新型切割工作盘，包括主体，主体为不锈钢体，主体呈方形，主体的四边最外侧具有围边，主体的中部为相对围边下沉的切割区，主体的侧面成型有凸块，凸块上开设有安装孔；本实用新型采用不锈钢主体，移动时不会被撞裂、撞碎，通过每个侧面成型凸块实现安装更稳固，同时，既可以切圆形CSP基板，还可以切方形CSP基板，使用寿命长，生产精度高。



1. 切割工作盘,其特征在于:包括主体,主体为不锈钢体,主体呈方形,主体的四边最外侧具有围边,主体的中部为相对围边下沉的切割区,主体的侧面成型有凸块,凸块上开设有安装孔。

2. 根据权利要求1所述的切割工作盘,其特征在于:所述的主体的四个侧面均分别成型有两个凸块。

3. 根据权利要求2所述的切割工作盘,其特征在于:所述的每个凸块的高度位置相同。

4. 根据权利要求1所述的切割工作盘,其特征在于:所述的主体呈扁平板状,主体的底面为水平面。

5. 根据权利要求3所述的切割工作盘,其特征在于:所述的凸块的顶面与围边的顶面平齐。

切割工作盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及半导体切割设备技术领域,特指一种切割工作盘。

背景技术

[0002] 在半导体行业,CSP (Chip Scale Package,芯片尺寸封装)基板的使用越来越多,在应用CSP基板之前,需要对CSP基板进行切割,切割出需要的尺寸。现有的切割工作盘,一般采用陶瓷材料制作,在移动的时候,比较容易撞裂、撞碎。另外,现在的切割工作盘的安装固定方式比较简单,不利于半导体的稳定精确切割。

[0003] 因此,基于上述现有的切割工作盘的缺陷,需要对现有的切割工作盘进行改进。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于针对现有技术的不足提供一种切割工作盘,该切割工作盘解决了现有的切割工作盘所存在的:易撞裂、撞碎、安装不够稳固等缺陷。

[0005] 为实现上述目的,本实用新型是通过以下技术方案实现的:切割工作盘,包括主体,主体为不锈钢体,主体呈方形,主体的四边最外侧具有围边,主体的中部为相对围边下沉的切割区,主体的侧面成型有凸块,凸块上开设有安装孔。

[0006] 所述的主体的四个侧面均分别成型有两个凸块。

[0007] 所述的每个凸块的高度位置相同。

[0008] 所述的主体呈扁平板状,主体的底面为水平面。

[0009] 所述的凸块的顶面与围边的顶面平齐。

[0010] 本实用新型的有益效果在于:采用不锈钢主体,移动时不会被撞裂、撞碎,通过每个侧面成型凸块实现安装更稳固,同时,既可以切圆形CSP基板,还可以切方形CSP基板,使用寿命长,生产精度高。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型的结构示意图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图对本实用新型作进一步的说明。

[0013] 见图1,本实用新型切割工作盘包括:主体1、围边2、切割区3、凸块4、安装孔5、下凹槽6。

[0014] 本实用新型包括有包括:主体1,主体1为不锈钢体,主体1的四边最外侧具有围边2,主体1的中部为相对围边2下沉的切割区3,主体1的侧面成型有凸块4,凸块4上开设有安装孔5。

[0015] 本实用新型的主体1呈方形,既可以切圆形CSP基板,还可以切方形CSP基板,一次最大可以切8块CSP基板,提高生产效率。

[0016] 本实用新型的主体1的四个侧面均分别成型有两个凸块4,每个凸块4的高度位置相同。

[0017] 本实用新型的主体1呈扁平板状,主体1的底面为水平面。

[0018] 本实用新型的切割区3内成型有多条下凹槽6,下凹槽6有两组,每组下凹槽6有多条且平行排列,其中一组下凹槽6与另一组下凹槽6垂直而呈交错排列状。

[0019] 本实用新型的下凹槽6与主体1的围边2呈45度设置。

[0020] 本实用新型移动时不会被撞裂、撞碎,而且安装更稳固,同时,既可以切圆形CSP基板,还可以切方形CSP基板。

[0021] 当然,以上所述之实施例,只是本实用新型的较佳实例而已,并非限制本实用新型实施范围,故凡依本实用新型申请专利范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均应包括于本实用新型申请专利范围内。

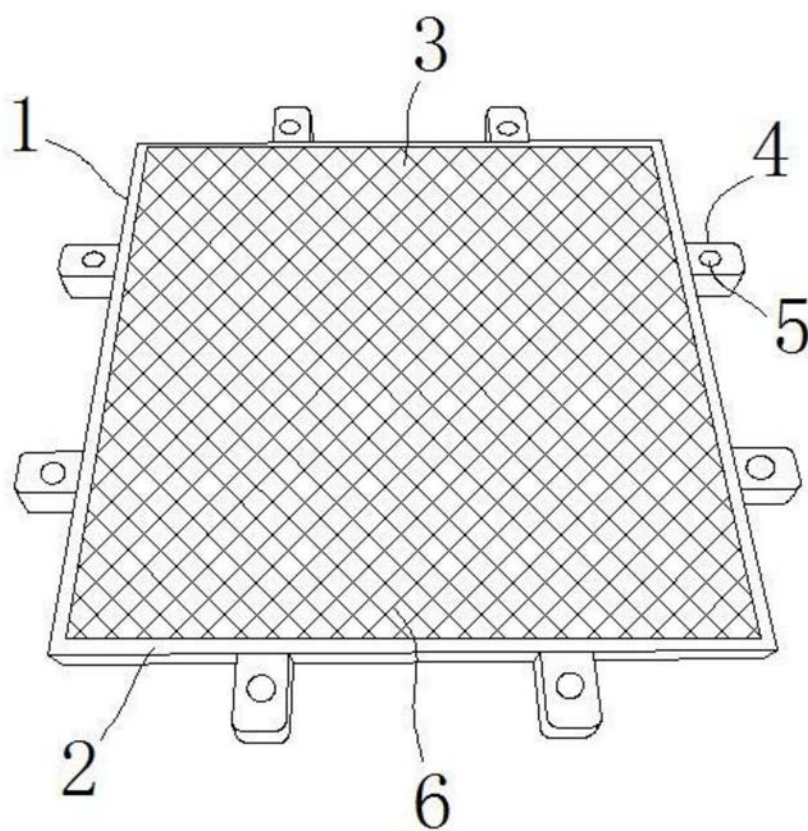


图1